Super Fast Recovery Diode

SF8L60USM

600V 8A

特 長
- 低ノイズ
- trr=25ns
- フルモールド
- 絶縁耐圧 2kV保証

Feature
- Low Noise
- trr=25ns
- Full Molded
- Dielectric Strength 2kV

用 途
- スイッチング電源
- 家電、OA
- 通信
- フライホール

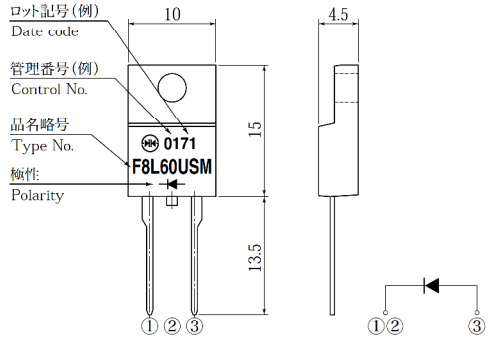
Main Use
- Switching Regulator
- Home Appliance, Office Automation
- Communication
- Fly Wheel

■外観図 OUTLINE

Package：FTO-220A

Unit：mm

Weight 1.9g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈ダイオードカタログ・技術資料編〉を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings（指定のない場合 Tc＝25℃）

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions / 品名 Type No.	SF8L60USM	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		−55〜150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}		600	V
最大順電流 Repetitive Peak Forward Current	I_{FM}	50Hz正弦波，抵抗負荷，Tc＝58℃，フィン付き 50Hz sine wave, Resistance load, Tc=58℃, With heatsink	25	A
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz正弦波，抵抗負荷，Tc＝58℃，フィン付き 50Hz sine wave, Resistance load, Tc=58℃, With heatsink	8	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波，非繰り返し1サイクルせん頭値，Tj＝25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃	60	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	Vdis	一括端子・ケース間，AC 1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	（推奨値：0.3N・m） (Recommended torque : 0.3N・m)	0.5	N・m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics（指定のない場合 Tc＝25℃）

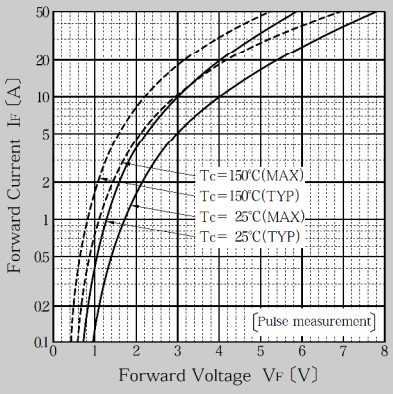
順電圧 Forward Voltage	V_F	I_F＝8A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 3.6	V
逆電流 Reverse Current	I_R	V_R＝600V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 50	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I_F＝0.5A, I_R＝1.0A	MAX 25	ns
接合容量 Junction Capacitance	Cj	f＝1MHz, V_R＝10V	TYP 24	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 2.5	℃/W

★記載内容は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

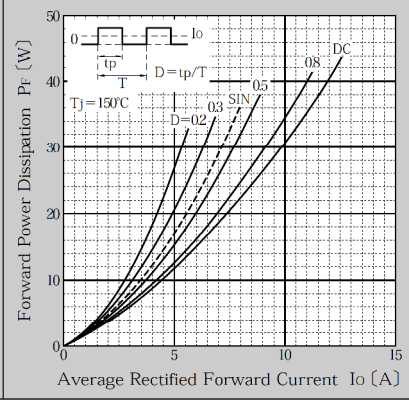
★All specifications are subject to change without notice.

■特性図　CHARACTERISTIC DIAGRAMS

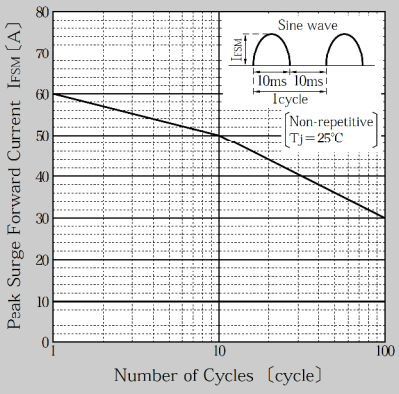
順方向特性
Forward Voltage



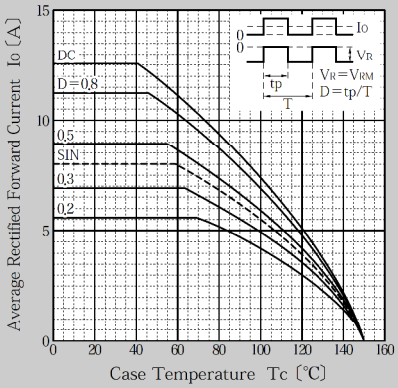
順電力損失曲線
Forward Power Dissipation



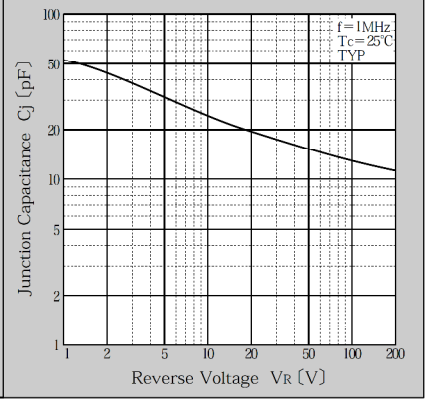
せん頭サージ順電流耐量
Peak Surge Forward Current Capability



ディレーティングカーブ Tc-Io
Derating Curve Tc-Io



接合容量
Junction Capacitance



＊Sine waveは50Hzで測定しています。
＊50Hz sine wave is used for measurements.
＊半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typicalは統計的な実力を表しています。
＊Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

★記載内容は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。
★All specifications are subject to change without notice.